

SMD-25628E

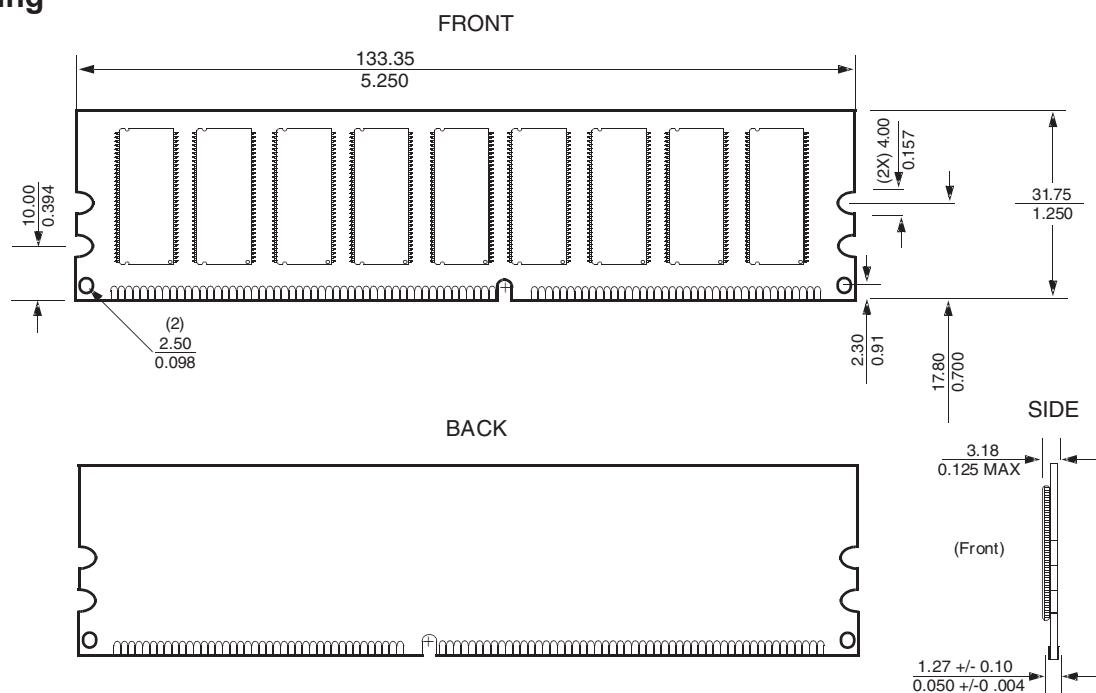
DESCRIPTION

SMD - 2 5 6 2 8 Eは、2 5 6 MビットDDR・DRAM (64M x 8bit) を9個搭載した3 2 M x 7 2 ビットDDR・DRAMモジュールです。

FEATURES

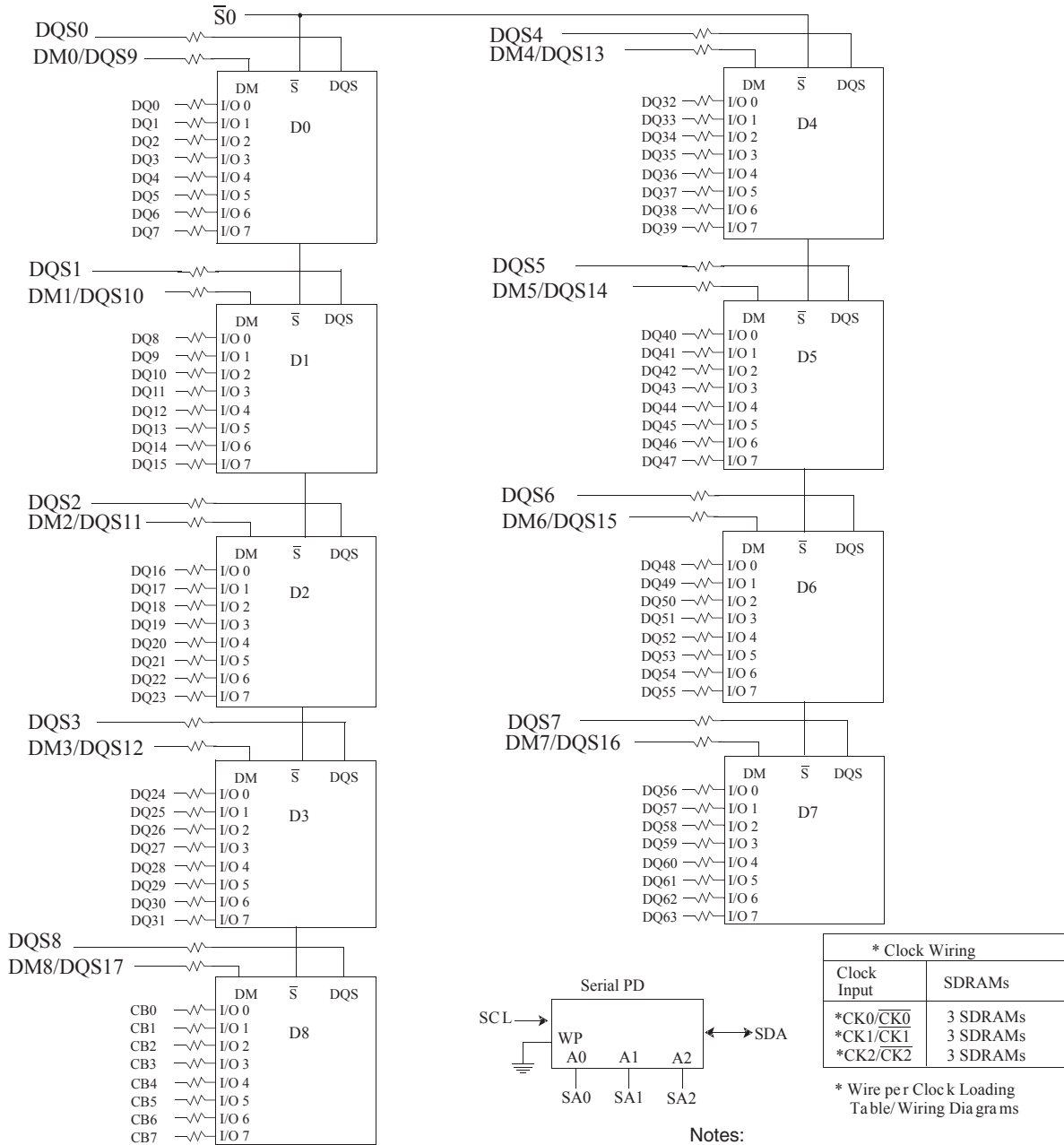
- ・ 1 8 4 ピン・デュアル・インライン・メモリ・モジュール
(ピン・ピッチ 1.27mm)
- ・ 基板高 1.25 "(31.75mm)
- ・ CL - tRCD - tRP=3 - 3 - 3 (PC3200) 2.5 - 3 - 3 (PC2700 / PC2100)
- ・ 2.6V ± 0.1V 単一電源 (PC3200) 2.5V ± 0.2V (PC2700 / PC2100)
- ・ 8, 192 リフレッシュ / 64ms
- ・ SSTL_2 コンパチブル
- ・ /CAS レイテンシー 3.0, 2.5, 2.0 クロックプログラマブル (PC3200)
- ・ " 2.5, 2.0 クロックプログラマブル (PC2700 / PC2100)
- ・ 1バンク構成
- ・ アンバッファードタイプ
- ・ シリアルPD
- ・ 接続端子: 電解金メッキ (t 0.76 μm)
- ・ ECC

Outline Drawing

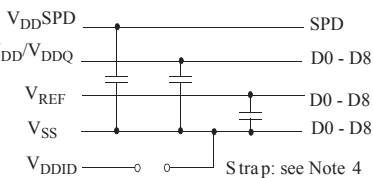


Note: All dimensions are typical unless otherwise stated $\frac{\text{millimeters}}{\text{inches}}$

Functional Block Diagram



- BA0 - BA1 → BA0-BA1: SDRAMs D0 - D8
- A0 - A12 → A0-A12: SDRAMs D0 - D8
- $\overline{\text{RAS}}$ → $\overline{\text{RAS}}$: SDRAMs D0 - D8
- $\overline{\text{CAS}}$ → $\overline{\text{CAS}}$: SDRAMs D0 - D8
- CKE0 → CKE: SDRAMs D0 - D8
- $\overline{\text{WE}}$ → $\overline{\text{WE}}$: SDRAMs D0 - D8



Notes:

1. DQ-to-I/O wiring is shown as recommended but may be changed.
2. DQ/DQS/DM/CKE/S relationships must be maintained as shown.
3. DQ, DQS, DM/DQS resistors: 22 ohms ± 5%.
4. V_{DDID} strap connections (for memory device V_{DD}, V_{DDQ}):
STRAP OUT (OPEN): V_{DD} = V_{DDQ}
STRAP IN (V_{SS}): V_{DD} ≠ V_{DDQ}.
5. BA_x, A_x, $\overline{\text{RAS}}$, $\overline{\text{CAS}}$, $\overline{\text{WE}}$ resistors: 5.1 ohm ±5% (Except PC2100)